

Кінетичні явища у напівпровідниках		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання	
Блок В																				
Енергетичні спектри і оптичні властивості досконалих і легованих квазідвовимірних напівпровідникових наногетеро-структур	4				4,0	120	30	15		15		90			2,0				професійної та технологічної освіти і загальної фізики	
Числові методи в теоретичній фізиці		3			4,0	120	30	15		15		90			2,0				теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання	
Кінетичні явища у напівпровідниках		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання	
Усього	1	2			12,0	360	90	45	15	30		270			4,0	2,0				
Всього за навчальним планом	5	8			45	1350	495	195	195	105		855	7	11	7	8				
Кількість годин на тиждень													7,0	11,0	7,0	4,0				
Кількість екзаменів														3	1	1				
Кількість заліків													3	1	2	2				

Фізика твердого тіла

Блок А																			
Фізика поверхні та наноматеріали	4				4,0	120	30	15		15		90			2,0				фізики твердого тіла
Методи та технології отримання наноматеріалів		3			4,0	120	30	15		15		90			2,0				професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Методи дослідження об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				фізики твердого тіла
Блок Б																			
Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів	4				4,0	120	30	15		15		90			2,0				фізики твердого тіла
Фізичне та прикладне матеріалознавство		3			4,0	120	30	15		15		90			2,0				фізики твердого тіла

g.m
g.8

Прикладне застосування Фур'є та вейвлет аналізу у фізиці твердого тіла		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				компютерних систем і мереж
--	--	---	--	--	-----	-----	----	----	----	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	----------------------------

Блок В

Фізика низькорозмірних систем	4				4,0	120	30	15		15		90			2,0				фізики твердого тіла
Магнітні наноматеріали		3			4,0	120	30	15		15		90			2,0				фізики твердого тіла
Фізика колоїдних систем		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				фізики твердого тіла
Усього	1	2			12,0	360	90	45	15	30		270			4,0	2,0			
Всього за навчальним планом	5	8			45	1350	495	195	195	105		855	7	11	7	8			
Кількість годин на тиждень												7,0	11,0	7,0	8,0				
Кількість екзаменів													3	1	1				
Кількість заліків												3	1	2	2				

Оптика, лазерна фізика

Блок А

Креляційна оптика	3				4,0	120	30	15	15			90			2,0				кореляційної оптики
Методи топології в оптиці	3				4,0	120	30	15	15			90			2,0				кореляційної оптики
Радіооптика		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				кореляційної оптики

Блок Б

Лазерна поляриметрія оптично неоднорідних шарів	3				4,0	120	30	15	15			90			2,0				оптики і ВПС
Теорія розповсюдження випромінювання в середовищах	3				4,0	120	30	15	15			90			2,0				оптики і ВПС
Сучасні підходи та методи когерентної і поляризаційної оптики		3			4,0	120	30	15	15			90			2,0				оптики і ВПС
Усього	2	1			12,0	360	90	45	45			270			6,0				
Всього за навчальним планом	6	7			45	1350	495	195	225	75		855	7	11	9	6			
Кількість годин на тиждень												7,0	11,0	9,0	6,0				
Кількість екзаменів													3	3					
Кількість заліків												3	1	1	2				

Фізика напівпровідників і діелектриків

Блок А

Напівмагнітні напівпровідникові матеріали		3			3,0	90	15	7		8		75			1,0				електроніки і енергетики
---	--	---	--	--	-----	----	----	---	--	---	--	----	--	--	-----	--	--	--	--------------------------

Фізичні основи твердотільної електроніки	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Основи спінтроніки		3		3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Новітні технології у напівпровідниковому матеріалознавстві	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики

Блок Б

Напівпровідникові джерела світла і приймачі оптичного випромінювання	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Використання корпускулярних потоків у технологічних процесах електроніки та зондових методах аналізу		3		3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Напівпровідникові детектори Х- і γ-випромінювання	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Волоконно-оптичні лінії зв'язку		3		3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики

Блок В

Напівмагнітні напівпровідникові матеріали		3		3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Технологія напівпровідникових мікро- та наноструктур	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						фізики напівпровідників і наноструктур
Фізика напівпровідникових низькорозмірних структур		3		3,0	90	15	7	8		75			1,0						фізики напівпровідників і наноструктур
Фізичні основи твердотільної електроніки	4			3,0	90	15	7	8		75			1,0						електроніки і енергетики
Усього	2	2		12	360	60	28		32	300			2	2					

Всього за навчальним планом	7	6		45	1350	435	163	180	92		915	7	9	5	8						
Кількість годин на тиждень												7,0	9,0	5,0	8,0						
Кількість екзаменів												2	2	1	2						
Кількість заліків												1	1	2	2						

Навчальний план затверджено Висою радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича (протокол № 8 від " 31 " серпня 2016 року)

Гарант освітньої програми

С.В. Мельничук

Погоджено

Начальник навчального відділу

Я.Д. Гарабазів

Директор ІФТКН

О.В. Ангельський

